

性能特点：

- 输出信号：-5V/0V
- 开关时间：20ns
- 芯片尺寸：0.7mm×0.85mm×0.1mm

产品简介：

HH-FEN1 是 1 位负压输出 FET 驱动器芯片,采用 GaAs 工艺制作,可将输入的 TTL 脉冲信号生成-5.1V/-0.3V 的互补脉冲信号输出。该产品可广泛应用于控制 FET 开关、数控衰减器、数控移相器等电路。

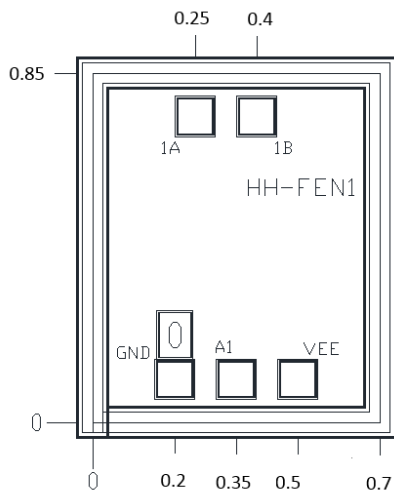
电参数： (TA=25°C, VEE=-5V)

| 指标 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
|-------|------|------|-----|-----|-----|----------|
| 静态电流 | Iees | - | - | 1 | mA | - |
| 驱动电流 | Io | - | 0.2 | - | mA | 与负载有关 |
| 输入电流 | Ii | - | 0.2 | - | mA | 单路 |
| 输出高电平 | Vh | -0.3 | - | - | V | 开路 |
| 输出低电平 | VI | -5.1 | - | - | V | 开路 |
| 开关时间 | ts | - | 15 | - | ns | f=100KHz |
| 工作频率 | f | - | 10 | - | MHz | 与负载有关 |

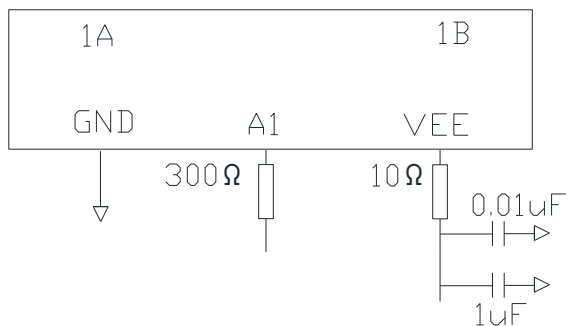
真值表：

| VEE=-5V | | | |
|---------|-------|-------|----|
| 型号 | 输入(V) | 输出(V) | |
| | A1 | 1A | 1B |
| HH-FEN1 | 0 | 0 | -5 |
| | 5 | -5 | 0 |

尺寸图：(单位 mm)



建议装配图：



使用说明：

存储：芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中，并在氮气环境下保存。

清洁处理：裸芯片必须在净化环境中操作使用，禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护：请严格遵守 ESD 防护要求，避免器件静电损伤。

常规操作：拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作：芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶焊接或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作：输入输出各用 2 根（建议直径 25um 金丝）键合线，键合线长度小于 250um 最优。建议采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点，终止于封装（或基板）。